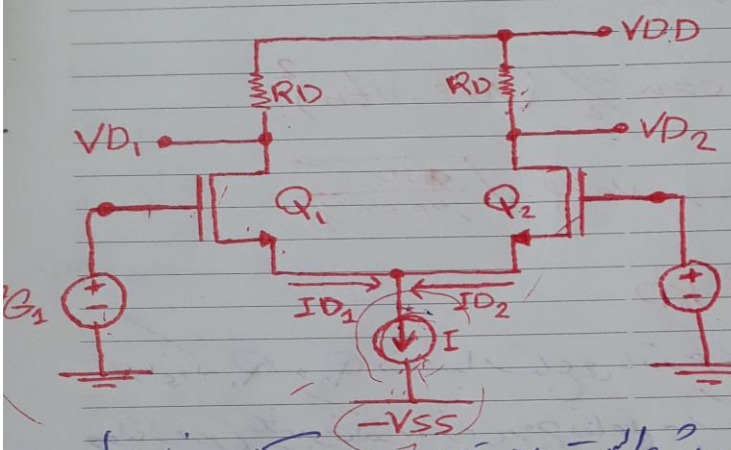


سه درس اول الکترونیک پیشرفته
(مدار مجتمع)

دکتر رستمی زاده

تفاوت گیت های تفاضلی

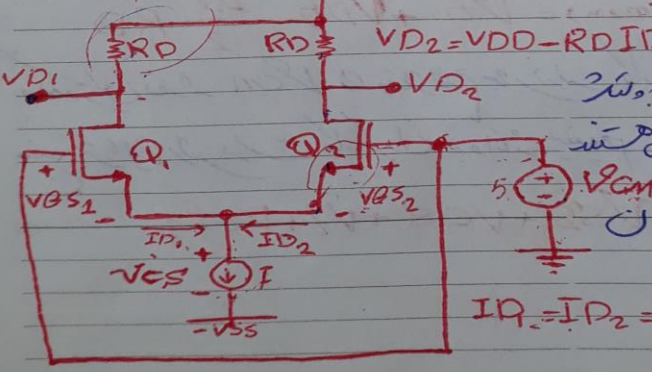


۱ در این مدار هر دو ترانزیستور Q_1 و Q_2 استفاده شده است که بزرگسایمان به هم گره متصل شده اند و توسط منبع جریان I بایس کرده اند.
 ۲ نکته منبع جریان I نیز توسط ولتاژ V_{GS} ایجاد می کنند که در این

۳ مدار از منبع جریان ایده آل استفاده شده است یعنی مقاومت خروجی آن بی نهایت است.
 ۴ در این شکل هر دو ترانزیستور RD به منبع تغذیه وصل است ولی می توان بجای آن یک بار عموماً اتصال استفاده کرد

نکته: بار هر نوعی که باشد مهم این است که مقاومت کم آوردن آن به ترانزیستور نشوند

۵ خروج تفاضلی به ازای ورودی حالت درستی: $V_{D1} = V_{DD} - R_D I_{D1}$



۶ در این شکل دو بار یکدیگر به هم وصل و به ولتاژ V_{CM} بنام ولتاژ حالت مشترک متصل هستند.
 ۷ یعنی $V_{GS1} = V_{GS2} = V_{CM}$ و چون Q_1 و Q_2 به هم منطبق هستند جریان I بصورت در بین آنها $I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_D}{2}$

$(V_1 - V_2) = \dots$

سپهر

۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸
۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵
۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲
					۳۰	۲۹

ش ی د س ج پ ج

تقریبی بود بنابراین در مدار این طول کانال رو طبق زیره خواهم داشت:

$$V_{DS} = V_{CM} - V_{GS}$$

$$I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_D}{2} = \frac{1}{2} \mu n c o x \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{tn})^2$$

$$(V_{eff})^2 = \frac{I_D}{\mu n c o x \frac{W}{L}} \Rightarrow V_{eff} = \sqrt{\frac{I_D}{\mu n c o x \frac{W}{L}}}$$

$$V_{D1} = V_{D2} = V_{DD} - \frac{I_D}{2} R_D$$

کارمانی که Q_1 و Q_2 در ناحیه اشباع می مانند جریان I بطور معاد در بین آنها تقسیم می شود و ولتاژ درین تغییر نمی کند بنابراین زوج تفاضلی به سگنال بار درودی حالت مشترک پاسخ نمی دهد به عبارتی آنها حذف می کنند.

یک متغیر هم تقویت کننده های تفاضلی باره درود حالت مشترک است

این باره در تغایر V_{cm} است که به ازای آن زوج تفاضلی ولت عمل می کند

ولتاژین مقدار V_{cm} توسط شرط ماندن Q_1 و Q_2 در اشباع محدود می شود

ولتاژین مقدار V_{cm} و ولتاژ لازم برای درت کار کردن منبع I تعیین می کنند

منبع جریان برای درت کار کردن به ولتاژ منبع V_{GS} نیاز داشته باشیم داریم:

$$V_{CM(min)} = -V_{SS} + V_{GS} + V_t + V_{eff}$$

۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸
۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵
۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲
				۳۰	۲۹	

مثال: اگر در زوج تفاضلی شکل قبل (و در حالت شش) داشته باشیم:

$$V_{DD} = V_{SS} = 1.5V \quad V_{Tn} = 0.5V \quad \mu n C_{ox} \frac{W}{L} = 4 \frac{mA}{V^2}$$

$$I_D = 0.4 mA \quad R_D = 2.5 k\Omega$$

۱- نکته: در دوولتا سینول طول کانال طرف نظر شود

۱۱- هر دو ایندی منبع جریان در یک گیت ولتاژ نویسی آن (VGS) نباید از ۱/۴ ولت کمتر شود

۱۲- تلف: مقادیر V_{GS} , V_{DS} و V_{DS} هر دو برابر هم باشند.

$$I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_D}{2} = \frac{1}{2} \mu n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{ov})^2$$

$$V_{ov} = \sqrt{\frac{I_{D1}}{\mu n C_{ox} \frac{W}{L}}} = \sqrt{\frac{0.4}{4}} = 0.316V$$

$$V_{ov} = V_{GS} - V_{Tn} \Rightarrow V_{GS} = V_{ov} + V_{Tn} = 0.316 + 0.5 = 0.82V$$

- $V_{CM} = 0$
- $V_{CM} = 1$
- $V_{CM} = -0.2$

۱۷- ب: مقادیر V_{GS} , I_{D1} , I_{D2} , V_{D1} و V_{D2} را از این مقادیر

$$V_{CM} = 0 \begin{cases} V_S = V_{CM} - V_{GS} \Rightarrow V_S = 0 - 0.82 = -0.82V \\ I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_D}{2} = \frac{0.4}{2} = 0.2 mA \\ V_{D1} = V_{D2} = V_{DD} - \frac{I_D}{2} R_D = 1.5 - (0.2 \cdot 2.5) = 1V \end{cases}$$

$$V_{CM} = 1 \begin{cases} V_S = V_{CM} - V_{GS} \Rightarrow V_S = 1 - 0.82 = 0.18V \\ I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_D}{2} = \frac{0.4}{2} = 0.2 mA \\ V_{D1} = V_{D2} = 1V \end{cases}$$

$$(v_1 - v_2) - (v_1 - v_2) = v_1 - v_2 - v_1 + v_2 = 0$$



در دو حالت $V_{CM} = 0$ و $V_{CM} = 1$ مازید بر آن در ناحیه اشباع هستند و جریان های I_{D1} و I_{D2} و ولتاژ های V_{D1} و V_{D2} تغییر نمی کنند هر چند ولتاژ V_{CM} به اندازه یک ولت تغییر کرده است

$$V_{CM} = -0.2 \begin{cases} V_S = V_{CM} - V_{GS} = -0.2 - 0.82 = -1.02V \\ V_{CS} = V_S - (-V_{SS}) = -1.02 + 1.5 = 0.48V \\ I_{D1} = I_{D2} = \frac{I}{2} = 0.2mA \\ V_{D1} = V_{D2} = 1V \end{cases}$$

در این حالت مقدار $V_{CS} = 0.48V$ است و ولتاژ $V_{GS} = -1.02V$ است
تغییر جریان همواره در است کار می کند و مقدار آن ثابت و برابر $4mA$ است
همه اینها هم در تفاضلی به تغییر ولتاژ حالت مشترک یا منبعی رده

ج: محدوده V_{CM} را حساب کنید

$$V_{CM(max)} = V_{GS} + (V_{DD} - \frac{I}{2} R_D) = 0.4 + 1 = 1.5V$$

$$V_{CM(min)} = -V_{SS} + V_{CS} + V_{GS} + V_{GS} \Rightarrow$$

$$V_{CM(min)} = -V_{SS} + V_{CS} + V_{GS} + (V_{GS} - V_{GS}) \Rightarrow$$

$$V_{CM(min)} = -V_{SS} + V_{CS} + V_{GS} = -1.5 + 0.4 + 0.82 = -0.28V$$

$$(v_1 - v_2)(1 - v_1) = v_1 - v_2 - v_1^2 + v_1 v_2$$

تقریباً به این صورت است که در بالا محروم V_{CM} دارد حالتی که R_D در برابر R_{D2}

حساب کنید $V_{t1} = -0.5V$ $V_{D1} = V_{SS} = 1.5V$
 $\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 4 \frac{mA}{V^2}$ $I_D = 0.4 mA$ $R_D = 5K$

$V_{CM(max)} = V_{t1} + V_D = V_{t1} + (V_{DD} - \frac{I_D R_D}{2}) = -0.5 + 0.5 = 0V$

$V_{CM(min)} = -V_{SS} + V_{t2} + V_{GS} = -1.5 + 0.4 + V_{GS} = ?$

$V_{GS} = V_{ov} + V_{t2} \Rightarrow V_{ov} = \sqrt{\frac{I_D}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}} = \sqrt{\frac{0.4}{4}} = 0.316V \Rightarrow$

$V_{GS} = 0.316 + 0.5 = 0.816 \approx 0.82V$

$V_{CM(min)} = -1.5 + 0.4 + 0.82 = -0.28V \Rightarrow$

هجرت حضرت امام خمینی (ره) از عراق به پاریس (۱۳۵۷ هـ ش) - روز نیروی انتظامی

$1 > V_{CM} > -0.28$

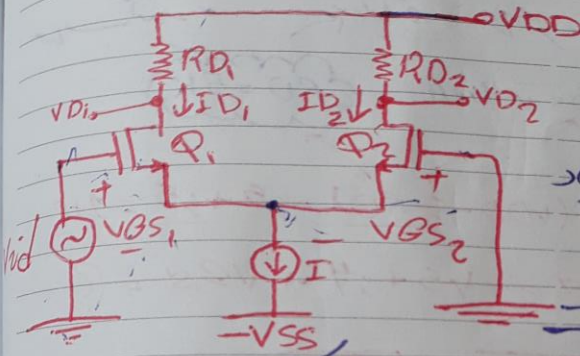
$(1 - \gamma_1)(1 - \gamma_2) = \gamma_1 - \gamma_2$

مهر

۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸
۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵
۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲
					۳۰	۲۹

ش ی د س ج پ ح

محلرد زوج تفاضلی به ازای ولتاژ ورودی تفاضلی



مطابق شکل با زمین کردن

نیمت دوم و اعمال سینال V_{id} به

نیمت اول یک ولتاژ ورودی تفاضلی ایجاد

می کنیم به سادگی می توان اینده

نیمت $V_{id} = V_{GS1} - V_{GS2}$ است اگر نیمت

نیمت V_{GS1} از V_{GS2} بزرگتر $ID1$ و $ID2$ بزرگتر است بنابراین

تولید خروجی تفاضلی $V_{D2} - V_{D1}$ مثبت می باشد و می توانیم V_{id} مثبت یا منفی

V_{GS1} از V_{GS2} کوچکتر $ID1$ از $ID2$ کوچکتر بنابراین و کار خروجی

$V_{D2} - V_{D1}$ منفی می شود

if: $V_{id} > 0$ $\left\{ \begin{array}{l} V_{G1} > V_{G2} \\ I_{D1} > I_{D2} \end{array} \right. \Rightarrow V_{D2} - V_{D1} = V_{out} > 0$

if: $V_{id} < 0$ $\left\{ \begin{array}{l} V_{G1} < V_{G2} \\ I_{D1} < I_{D2} \end{array} \right. \Rightarrow V_{D2} - V_{D1} < 0$

توضیح بالا نشان می دهد که زوج تفاضلی با ایجاد یک سینال خروجی تفاضلی

این درین حالتی هم اینده چه مقدار V_{id} باشد می شود که کل جریان I

از یک ترانزیستور بگذرد بین صورت است که در جهت مثبت این اتفاق

وقتی رخ می دهد که V_{GS1} مقدار مستطری با $I = I_{D1}$ و V_{GS2} تا ولتاژ

۱) گیتن V_{th} و V_{GS1} یابید

$$V_{GS2} = v_{th} = V_{GS2} - V_{S2} \Rightarrow V_{S2} = -v_{th}$$
$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - v_{th})^2 \Rightarrow$$

$$(V_{GS} - v_{th})^2 = \frac{2I_D}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}} \Rightarrow V_{GS} - v_{th} = \sqrt{\frac{2I_D}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}}$$

$$V_{GS1} = v_{th} + \sqrt{\frac{2I_D}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}}$$

$$V_{GS1} - v_{th} = \sqrt{\frac{2 \times 2I_D}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}} = \sqrt{2} \times \sqrt{\frac{2I_D}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}} \Rightarrow$$

$$V_{GS1} = v_{th} + \sqrt{2} v_{eff}$$

که در آن v_{eff} و v_{th} افتادند تحریک متناظر با جریان درین I_{D2} است
درین مقدار v_{id} که باعث می‌شود کل جریان I از Q_1 بگذرد عبارت است از:

$$v_{id(max)} = V_{GS1} + V_{S1} \Rightarrow v_{id(max)} = v_{th} + \sqrt{2} v_{eff} - v_{th}$$

$$v_{id(max)} = \sqrt{2} v_{eff}$$

اگر $v_{id} > \sqrt{2} v_{eff}$ باشد v_{GS1} بیشتر شود $(v_{id} > \sqrt{2} v_{eff})$ بنابراین
 $i_{D1} = I \Rightarrow V_{GS1} = (v_{th} + v_{eff}) \Rightarrow V_{S1}$ و $Q_2 = off$

v_{id} کوچکتر از $\sqrt{2} v_{eff}$ شود $(v_{id} < \sqrt{2} v_{eff})$ بنابراین $i_{D2} = I$ و $Q_1 = off$
بنابراین برای چنانچه I از Q_1 بگذرد باید v_{id} باید در محدوده زیر

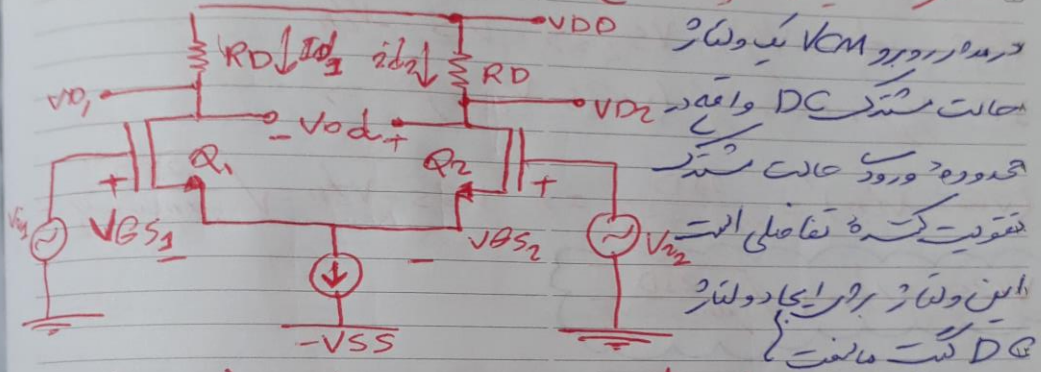
$$-\sqrt{2} v_{eff} < v_{id} < \sqrt{2} v_{eff}$$

مهر

۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸
۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵
۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲
				۳۰	۲۹	

ش ی د س ج ع ح

حکایت سیگنال خروجی تفاضلی ماسفت



$$V_{o1} = V_{CM} + \frac{1}{2} V_{id}$$

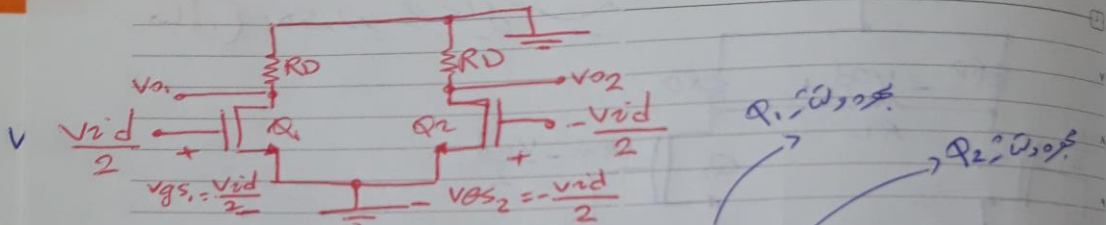
$$V_{o2} = V_{CM} - \frac{1}{2} V_{id}$$

مقدار متوسط دو منبع تغذیه است و در اینجا چون منابع تغذیه متصل هستند V_{CM} برابر می‌شود.

سیگنال تفاضلی ورودی V_{id} بصورت V_{GS1} و V_{GS2} اعمال شده یعنی اگر

V_{GS1} به اندازه $\frac{V_{id}}{2}$ افزایش یابد V_{GS2} به اندازه $\frac{V_{id}}{2}$ کاهش یابد. اگر تقویت کننده تفاضلی توانایی خوبی می‌تواند تقویت کننده تفاضلی را تقویت کند. استود چسب و ضیق ایجاد می‌شود.

در این مدار هدف تعیین نحوه ولتاژ در پالینگ در سیگنال تفاضلی ورودی V_{id} است. لذا بخاطر تقابل مدار و متعادل بودن اعمال V_{id} و سیگنال ولتاژ در محل اتصال مودس ترانزیستور باید صفر باشد این گره به نوعی زمین مجاز است بنابراین متعادل مدار بصورت زیر است:



$$V_{o1} = -(RD || r_d) \times \frac{v_{id}}{2} g_m \Rightarrow \frac{V_{o1}}{v_{id}} = -\frac{1}{2} g_m (RD || r_d)$$

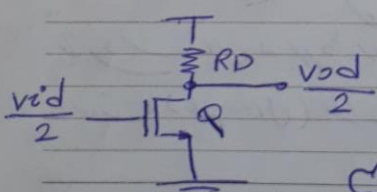
$$V_{o2} = (RD || r_d) \times \frac{v_{id}}{2} g_m \Rightarrow \frac{V_{o2}}{v_{id}} = \frac{1}{2} g_m (RD || r_d)$$

$$V_{od} = V_{o2} - V_{o1} = \frac{1}{2} g_m (RD || r_d) \Rightarrow$$

$$V_{od} = g_m (RD || r_d) \xrightarrow{r_d \gg RD} V_{od} = g_m RD$$

نیم مدار تفاضلی:

اگر یک تقویت کننده تفاضلی مستقیم تر نسبت به یک کینال تفاضلی به صورت متعادل می شود عملکرد مدار را می توان تنوید کرد و در نظر گرفتن نصف مدار تحلیل کرد.



$$A_d = \frac{\frac{v_{od}}{2}}{\frac{v_{id}}{2}} = \frac{v_{od}}{v_{id}} = -\frac{(RD || r_o)}{\frac{2}{g_m}} \Rightarrow$$

$$\frac{V_{od}}{v_{id}} = -g_m (RD || r_o)$$

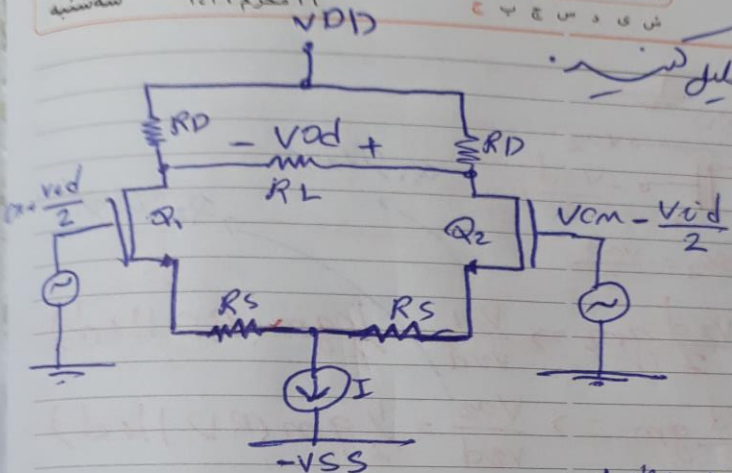
$$(1 - \gamma_1)(1 - \gamma_2) = \gamma_1 \gamma_2 - (\gamma_1 + \gamma_2) + 1$$

۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
۱۲	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸
۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵
۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲
					۳۰	۲۹

ش ی د س ج پ ع

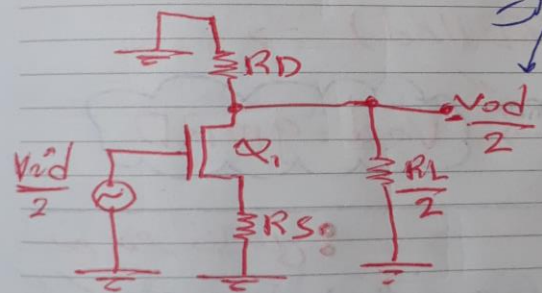
۱۳۵۱

مثال: مدار ترانزیستور و تحلیل آن



ترانزیستور نیم قدر، مدل سی لیم

$$\frac{v_{od}}{v_{id}} = -g_m(R_D || r_d || R_L)$$



$$A_v = -\frac{v_{od}}{v_{id}} = \frac{R_D || r_d || R_L}{R_S + \frac{1}{g_m}}$$

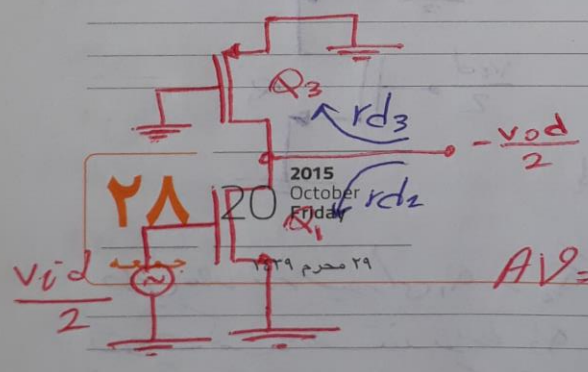
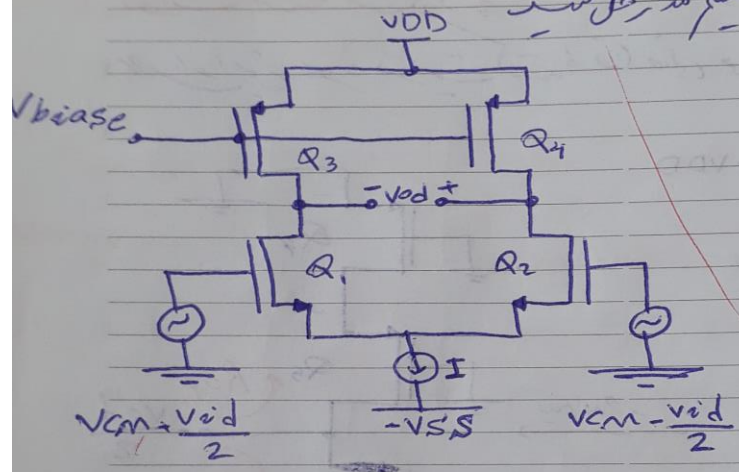
$$A_v = \frac{g_m(R_D || r_d || R_L)}{1 + g_m R_S}$$

تفاوت گسسته تفاضلی با بار منبع چیه؟

بردار سیگنالی به بزرگی از گسسته تفاضلی با بار منبع چیه؟
 ماسکت (بار مثال) طراحی دهنده که معمولاً از ترانزیستورهای P-MOS استفاده می‌کنند

$$v_{od} = -v_{id} \left(\frac{R_D || r_d || R_L}{R_S + \frac{1}{g_m}} \right)$$

مثال (۲) موزون بودن سیگنال در هر دو طرف

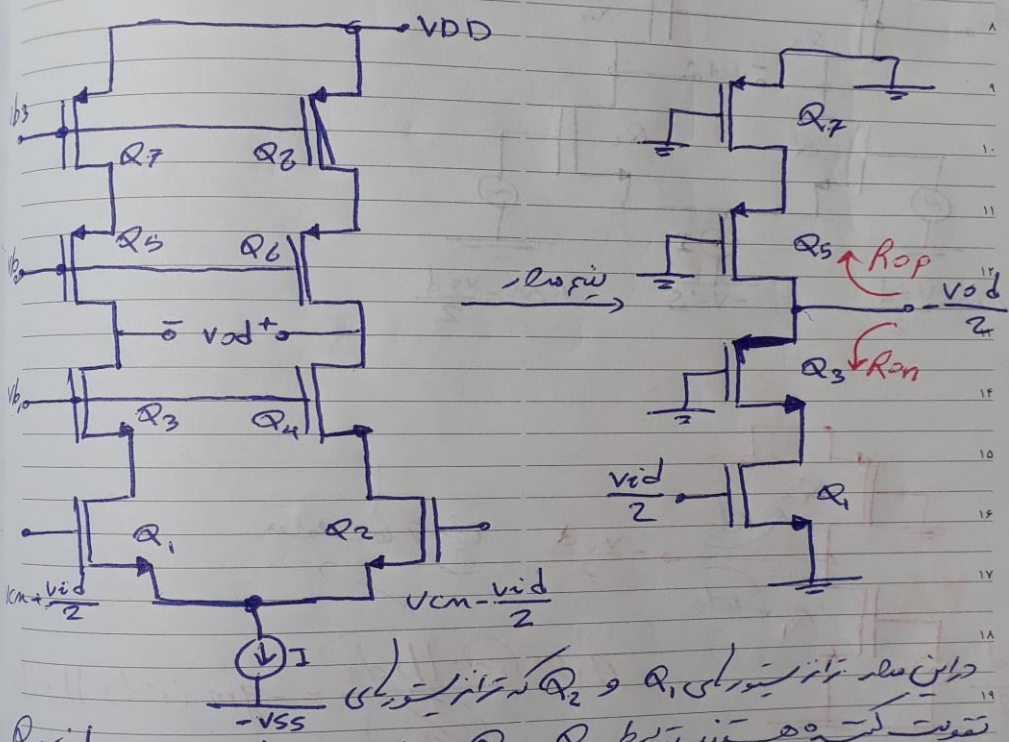


مقاومت خروجی

$$A_V = \frac{r_{d3} \parallel r_{d1}}{\frac{1}{g_m}} = -g_m (r_{d3} \parallel r_{d1})$$

مقاومت سیگنال ورودی

تقویت کننده کسود
 تقویت کننده تفاضلی می توان از این کسود استفاده کرد



این مدار ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 که ترانزیستورهای تقویت کننده هستند و Q_3 و Q_4 و ترانزیستورهای منبع جریان Q_7 و Q_8 و Q_5 و Q_6 که در مدار اندخیزه تفاضلی می توان از این مدار استفاده کرد:

$$R_{op} = (g_{m5} r_{o5}) r_{o7} = g_{m5} r_{o5} r_{o7}$$

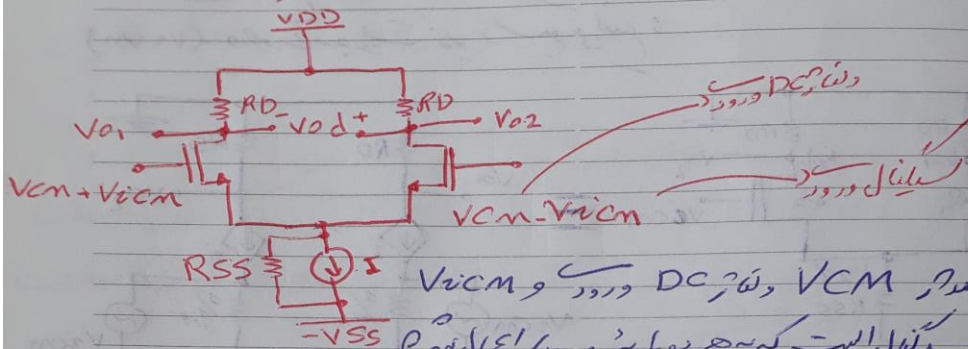
$$R_{on} = (g_{m3} r_{o3}) r_{o2} = g_{m3} r_{o3} r_{o2}$$

$$A_v = \frac{v_{od}}{v_{id}} = \frac{R_{op} \parallel R_{on}}{1/g_{m1}} \Rightarrow A_v = g_{m1} (R_{op} \parallel R_{on})$$

$$(1-x)(1-x)$$

۵	۴	۳	۲	۱
۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸
۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵
۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰
۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵

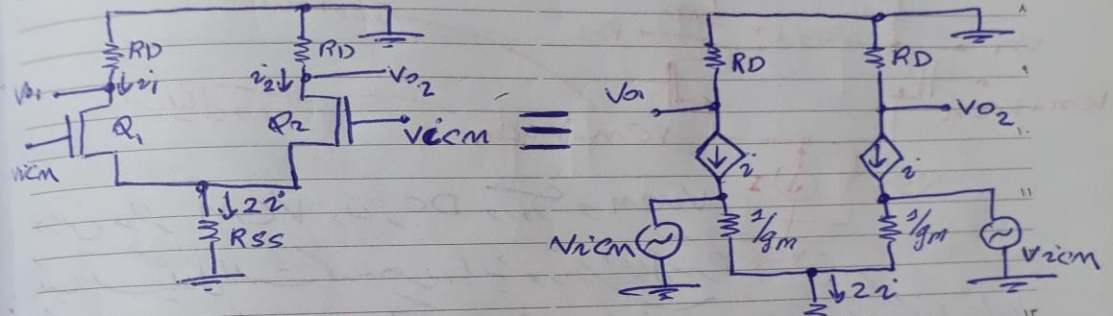
۲) مجزبه حالت مشترک و نسبت ورودی حالت مشترک $CMRR$



در این مدار V_{CM} ولتاژ DC ورودی و V_{icm} سیگنال ورودی است که به هر دو پایه ورودی اعمال می شود. سیگنال ورودی حالت مشترک را می توان بصورت یک سیگنال داخلی یا نویز که توسط هر دو ورودی دریافت می شود و سیگنال مطلوب نیست در نظر گرفت. هدف این است که تقسیم V_{icm} چگونگی به خوبی را به ما می یابد. عرض می کنیم که در مدار V_{icm} صف اولت در این حالت جریان بایاس I_{D1} و I_{D2} و I_{D3} نسبت بلکه مقدار نیز نسبت است که به V_{CM} و R_{SS} بستگی دارد ولی چون R_{SS} معمولاً خیلی بزرگ است این جریان DC اضافی ناخواسته است و آن را نادیده می گیریم بنابراین عرض می کنیم I_{D1} و I_{D2} با جریان بایاس $I_{D3}/2$ کار می کنند. عرض می کنیم باید توجه کنیم نسبت بایاس می شود چرا سیگنال در R_{SS} صف اولت در R_{SS} هیچ تأثیر ندارد A_d ندارد.

$$(1 - \gamma_0)(1 + \gamma_0)(1 - \gamma_0)$$

برای تعیین اینکه تفاوتی در سیگنال ورودی حالت مشترک (vicm) در خروجی وجود دارد یا نه، باید بررسی کنیم:



$$V_{icm} = (2 \times \frac{2}{g_m}) + (2R_{SS}) \Rightarrow$$

$$V_{icm} = 2 \left(\frac{1}{g_m} * 2R_{SS} \right) \Rightarrow$$

$$i = \frac{V_{icm}}{\frac{2}{g_m} + 2R_{SS}}$$

اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی (ره) علیه باند پلوش و کثرت لابیون (۱۳۴۳ هـ.ش)

$$V_{o1} = V_{o2} = -R_D i = -R_D \times \frac{V_{icm}}{\frac{2}{g_m} + 2R_{SS}} = -\frac{R_D}{\frac{2}{g_m} + 2R_{SS}} \times V_{icm} \Rightarrow$$

$$V_{o1} = -\frac{R_D}{\frac{2}{g_m} + 2R_{SS}} \times V_{icm}$$

$$\text{if } 2R_{SS} \gg \frac{1}{g_m} \Rightarrow \frac{V_{o1}}{V_{icm}} = \frac{V_{o2}}{V_{icm}} = -\frac{R_D}{2R_{SS}}$$

$V_{od} = V_{o2} - V_{o1} = 0$ هم برابر هستند
بنابراین در خروجی V_{o1} و V_{o2} سیگنال حالت مشترک V_{icm} آورده هستند، و چون V_{o1} و V_{o2} برابر است و لذا خروجی تفاضلی

$$(1+x)(1-x)$$

(V_{od}) عبارت از تداخل حالت مشترک است. لذا این مدار هنوز سینال حالت مشترک را حذف نمی کند ولی می تواند آن را به مقدار کمتری رساند. چنانچه نسبت

دو تا انتضاتی R_D به $CMRR$:

اگر دو مقاومت درین به اندازه ΔR_D باهم متفاوت نباشند و سایر ای حالت مشترک دو درین برابر نباشند اگر R_1 مقاومت R_D و R_2 مقاومت $R_D + \Delta R_D$ باشد آنگاه داریم:

$$V_{o1} = -\frac{R_D}{2R_{SS}} \times V_{icm}$$

$$V_{o2} = -\frac{R_D + \Delta R_D}{2R_{SS}} \times V_{icm}$$

$$V_{od} = V_{o2} - V_{o1} = -\frac{\Delta R_D}{2R_{SS}} \times V_{icm}$$

$$\frac{V_{od}}{V_{icm}} = -\frac{\Delta R_D}{2R_{SS}} = ACM$$

$$ACM = -\left(\frac{R_D}{2R_{SS}}\right) \times \left(\frac{\Delta R_D}{R_D}\right)$$

نکته: در مدار V_{o1} و V_{o2} با توجه به اینکه $\frac{1}{g_m}$ خیلی کوچک است و آن صرف نظر شده است. بنابراین تا انتضاتی مقاومت ای درین باشد می شود تقویت کننده تفاضلی بجز در حالت مشترک غیر صرفاً وارسته باشد. مندرج صورت بدون تقویت کننده تفاضلی در تقویت کننده ای تفاضلی و حذف تداخل حالت مشترک بصورت نسبت اندازه بجز در تفاضلی به اندازه بجز

۵	۴	۳	۲	۱		
۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶
۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳
۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰
			۳۰	۲۹	۲۸	۲۷



حالت مستقر یا می شود این نسبت را نسبت رد حالت مستقر

$$CMRR = \frac{|A_d|}{|A_{cm}|}$$

و CMRR می نامند

CMRR معمولاً به حسب دلیل بی می شود

$$CMRR (dB) = 20 \log \left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right|$$

نکته: زمانی تقویت در بهترین حالت است که CMRR بی نهایت میل کند یعنی A_{cm} باید کوچکتر و A_d باید بزرگتر باشد

$$A_d = g_m R_D$$

$$CMRR = \frac{A_d}{A_{cm}} = \frac{2g_m R_{SS}}{\frac{\Delta R_D}{R_D}} \rightarrow \text{نویس } R_D \text{ نامنتظی}$$

از آن نظای g_m

$$g_{m1} = g_m + \frac{1}{2} \Delta g_m$$

$$g_{m2} = g_m - \frac{1}{2} \Delta g_m \Rightarrow$$

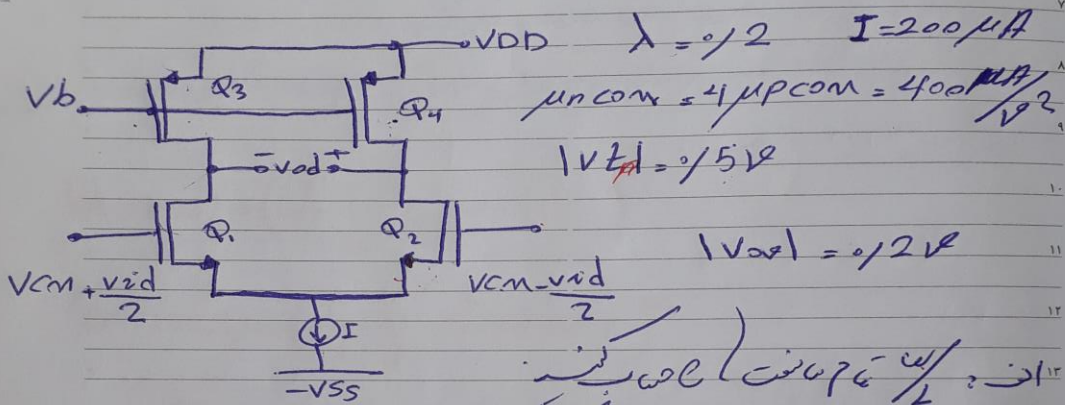
$$V_{od} = \frac{\Delta g_m R_D}{1 + g_m R_{SS}}, \quad V_{icm} \Rightarrow A_{cm} = \frac{V_{od}}{V_{icm}} = \frac{\Delta g_m R_D}{1 + g_m R_{SS}}$$

$$A_{cm} \approx \frac{R_D}{2R_{SS}} \times \frac{\Delta R_D}{g_m}$$

$$CMRR = \frac{2g_m R_{SS}}{\frac{\Delta g_m}{g_m}} \rightarrow \text{نویس } g_m \text{ نامنتظی}$$

۵	۴	۳	۲	۱
۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸
۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵
۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲
		۳۰	۲۹	۲۸
				۲۷

تمرین ۱) تقویت کننده تفاضلی ورودی با تلفظ در $1/2 \mu m$ ساخته شود



از v_{cm} و v_{ovd} استفاده کنید
ب: خروجی تفاضلی v_{od} را بیابید.